This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

																× 1	-	
										•								
			· · · .															
												\$						
													. •					
													5. j					
													,					
					,7	,		,	31				•.					
												1. 6						
												As .						
													:4				•	
									(.)		8 -							
													5 " -5					
											\$			r 13				
																	3 .0	
		4 2													Ψ,		i pr	
		× -		2 °C			lu lu			:			A				die	
					*,													e e
			ş-							*			· *§.	21				1
			·										de.		1.			i.
											¥						*	
								4.					9					
	. **																	
													Α Δ					
											, 4						1	7
												1 5 7 to 1					17	7
														* .				Y.
			,									¥ ·	*.\vec{v}_1 \\ v^*.	-				
						•						7	4.5					6.7
											1.3			rie Magai				T.
•												40	100					
														A .			٠.	/ ⁵
											4	9						
												9	P 2.		,	,		
٠							4			* 4		2.18		eri Colon				
							3					-		Paris.				
								ź.					7 .	8				
						*			. #	5. p.			7 3					
		. 8										4.7	2	N				
	1.0	,,4				*	at g					*	**			÷		
							•				· · · · ·	* ()				, S**	2.1	Ý
							8-2		18.4			7 * 1		3.0		M		
1																8 A	27 15	

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-368851

(43)公開日 平成4年(1992)12月21日

審査請求 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

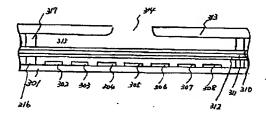
		•
(21)出願番号	特願平3-144576	(71)出願人 000002369
		セイコーエプソン株式会社
(22)出顧日	平成3年(1991)6月17日	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
		(72)発明者 大野 好弘
		長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエプソン株式会社内
		(72)発明者 跡部 光朗
		長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエブソン株式会社内
		(72)発明者 丹保 仁志
		長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
		ーエブソン株式会社内
		(74)代理人 介理士 鈴木 喜三郎 (外1名)

(54)【発明の名称】 磁場発生基板及びそれを用いたインクジエツトヘッド

(57)【要約】

【目的】本発明は、磁力反発を用いたインクジェットへッドにより、インクジェットへッドの長寿命化、高密度印字化、高速印字化を実現するものである。

【構成】本発明は、磁気発生基板、磁石が形成された基板、及びノズルブレートを貼り合わせることによりなるインクジェットヘッドである。



2

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上に複数個の電磁石を設置したことを 特徴とする磁場発生基板。

【蘭求項2】磁場発生基板上に、磁石の形成されたフィルムを貼り合わせ、該フィルムに任意の距離を保ってノズルプレートを設置したことを特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項3】フィルムに形成された磁場発生基板を、磁石と貼り合わせノズルブレートと磁場発生基板を対向させ、これを任意の距離を保って接着・接合したことを特 10 徴とするインクジェットヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は基板上に電磁石を複数 個、任意の位置に配置することによって、基板上の任意 の位置の磁場を変えることのできる基板に係り、これを 用いれば基板上に置かれた磁性体の位置を任意に変える ことが可能であり、磁性体の変位を目的としたあらゆる 分野に利用できる。特に、本発明はインク滴を飛翔させ 記録媒体上に画像を形成するインクジェットヘッドのア 20 クチュエーターに関するものである。

[0002]

【従来の技術】インクジェットヘッドの構造は種々提案されているが、現在実用化されているのはインク内での発熱体の熱発生によりインクの蒸発によるパブル発生で圧力を生じさせる方式(図4)と、ピエゾ等の圧電素子を基板に取り付け圧電素子の変形を利用し、基板を変位させることによりインク内の圧力を変化させる方式(図5)がある。

【0003】図4は発熱体方式によるインクジェットへ 30 ッドの断面図であるが、基板401に発熱体402を形成し、インクの吐出穴を持った基板 (ノズルプレート) 403を基板401に貼り付けることにより成るものである。前述のように発熱体402に通電することにより、インクを沸騰させパブルを発生させることによりインクジェットヘッド内の圧力を変化させ、インク404をノズル405から吐出させるタイプのものである。

【0004】図5は圧電方式のインクジェットヘッドの 断面図であるが、基板501にピエゾ等の圧電索子を貼 り付け、基板503と組み合わせることによりなるもの である。

【0005】圧電素子は、PZTのようなセラミックを 焼成により形成し、素子状に切り出すことにより得られ ており、こうして得られた圧電素子502に圧電を引加 することにより、インクジェットヘッド内の圧力を変化 させ、インク504を505のノズルから吐出させるタ イプのものである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】前述の発熱素子タイプ 及び圧電素子タイプはそれぞれ長短を持っている。 【0007】発熱タイプはいわゆる薄膜プロセスによって駆動体となる発熱案子を形成できるため、駆動案子の高密度化が容易であるが、発熱方式によるため、加熱、急冷により案子がダメージを受けること、及びインク中のパブル消滅時の衝撃により発熱体がダメージを受けることによりヘッド自体の寿命が短いという欠点があった。

2

【0008】また、一方の圧電素子タイプは発熱方式と は逆に上記のようなダメージがないためヘッド寿命は長 のいものの、圧電素子をセラミックプロックから切り出 し、貼り付けるという工程からわかるように駆動素子の 高密度化が困難な構造になっている。

【0009】また、両構造ともインク摘は前方へのみ吐出され、ヘッド面に対して角度をつけて(斜に)インク 摘を飛翔させることはできなかった。このため高速のライン印字を行うためには、印字部分に対応するだけの数のインクジェットヘッドを持ったラインヘッドが必要であった。このためヘッド数が多くなり、コストアップにつながっていた。

0 【0010】そこで本発明の目的はこのような課題を解決するもので、駆動素子の高密度化が可能で、長寿命で、インク滴の飛翔角度を変えることで印字範囲を広くし、少ないインクジェットヘッド数で高速印字の可能なインクジェットヘッドを提供するところにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】上配目的は、基板上に複数個の電磁石を設置した磁場発生基板上に、薄膜磁石の形成されたフィルムを貼り合わせ、該フィルムに任意の距離を保ってノズルプレートを設置することによるインクジェットヘッドにより達成される。

[0012]

【作用】本発明の構成であれば、磁石311と、その下に配置された電磁石の反発により、フィルム310が変形レフィルム上のインク315に圧力変化を生じさせ、インク吐出口からインク満を吐出させることができる。

【0013】また、図3において電流を流す電磁石をノズルに対して左側を用いればインク商は右側へ、電流を流す電磁石をノズルに対して右側に用いればインク商は左側へ飛翔する。即ち、電流を流す電磁石と電流量を任意に選ぶことにより、インク滴を任意の角度をもって飛ばすことができる。

[0014]

【実施例】(実施例1)以下本発明の実施例を図1、図 2、図3より説明する。

【0015】本発明の磁場発生基板を上方からみた図が図1である。基板101上に電磁石102をn行×m列配置したものであり、各電磁石は各々、電圧、電流コントローラーに接続されており、電圧、電流を変化させることにより各々の電磁石の発生する磁場を変化させるこ

40

3

【0016】電磁石102の形成方法を図2を用いて説 明する。

【0017】基板101上に所定のパターンを持ったコ イルを形成する。コイル部201は導電体で形成され、 金属、酸化物、有機物等の導電性の物質であれば何でも 良い。本実施例ではCr-Auを2ミクロンメートルの 厚さで蒸着により形成した後、フォトリソプロセスによ り図2の形状のコイルにパターニングした。

【0018】次に、上記プロセスで形成されたコイル上 分にコンタクトホール部203を形成した。 絶縁層とし ては酸化物、有機物何でもよく、本実施例では感光性ポ リイミド樹脂を2ミクロンメートルの厚さでロールコー ターにより皮膜し、フォトリソプロセスにより感光性ポ リイミド樹脂の硬化及びコンタクトホール部203を形 成した。

【0019】更に、コンタクトホール部203を通して 配線204を絶縁層202上に形成することで電磁石が 形成でき、本発明の磁場発生基板ができた。

【0020】以上のプロセスからわかるように、本発明 20 の磁場発生基板は基板全面への薄膜形成とフォトリソプ ロセスを用いて作られるため、各種の形状のコイル、及 びコイルの位置は任意に変えることが可能である。

【0021】また、各電磁石の磁界強度を増すために、 各電磁石の中心部に絶縁膜を介してFe、Ni、Co等 の磁性体神膜を形成してもよい。

【0022】次に、図3を用いてインクジェットヘッド としての使用方法を説明する。

【0023】301は前述の磁場発生基板の基板部分で れた電磁石である。

【0024】310は薄膜磁石311が形成されたフィ ルムである。この図では葬膜磁石は連続膜になっている が、薄膜磁石に切り込みを入れ、各電磁石に1対1で対 応させた独立磁石の集合体としても良い。

【0025】本実施例ではフィルムを厚さ10ミクロン メートルのポリイミドフィルムとし、薄膜磁石としては スパッタ法によりNd-Fe-Bを15ミクロンメート ルの厚さに形成したものとした。この薄膜磁石層の上に 絶縁膜としてSiO2 を2000オングストロームの厚 みで形成した。この薄膜磁石を膜面方向に磁化させ、磁 化方向をそろえたものを、磁場発生基板に密着、貼り合 わせた。

【0026】次に、直径50ミクロンメートルノズル部 314を持つ厚さ50ミクロンメートルノズルプレート 313を基板310との間隔が700ミクロンメートル となるようにエポキシ樹脂を用いて貼り合わせることに より、本発明のインクジェットヘッドを作製した。

【0027】インクを315の空間に満たした後、電磁 石304、305、306に電流を薄膜磁石の極性と反 50 301 基板

発するように流した。その結果、インクは垂直方向に飛 翔した。

【0028】次に同様の極性で、電磁石305、30 6、307、308に同じように電流を流すことで、図 3においてインクは左側へ角度をもって飛翔した。

【0029】インクの角度は作動させる電磁石及び流す 電流によって制御することができた。

【0030】 (実施例2) 実施例1と同様の方法で、複 数の電磁石を厚さ20ミクロンメートルのポリイミドフ に絶録層202を形成し、コイルのエンドポイントの部 10 ィルムに形成したものを磁場発生基板とし、電磁石上に 絶縁膜として1ミクロンメートルのポリイミド樹脂をコ ートした。

> 【0031】これを圧延されたプラセオジウム磁石に密 着貼り付けた。

> 【0032】こうして得られた基板を実施例1と同様な 方法で、磁場発生基板がノズルプレート側になるような 構造でインクジェットヘッドを作製した。

> 【0033】インクの飛翔及びそのヘッド面に対しての 角度は実施例1と同様の結果が得られた。

[0034]

【発明の効果】以上実施例よりわかるように、本発明の 磁場発生基板はICプロセスに代表される薄膜加工プロ セスにより形成されるため、電磁石の高密度化が可能で ある。

【0035】本発明の磁場発生基板を用いたインクジェ ットヘッドは、駆動に発熱方式を取らないため素子の寿 命が長く、かつ上配のように高密度な電磁石形成が可能 なこと、更に任意に駆動電磁石及び駆動電流を選ぶこと により、インク滴の飛翔角度を任意に変えることが可能 あり、302から308までは前述のプロセスで形成さ 30 になり、ヘッド数の少ない製造コストの低い高速印字可 能なインクジェットヘッドが製造可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の磁気発生基板を上面から見た図であ

【図2】本発明の電磁石の製造プロセスを示す図であ

【図3】本発明のインクジェットヘッドの断面図であ

【図4】従来の発熱式インクジェットヘッドの断面図で 40 ある。

【図 5】従来の圧電索子式インクジェットヘッドの断面 図である。

【符号の説明】

101 基板

102 電磁石

201 コイル (導電体)

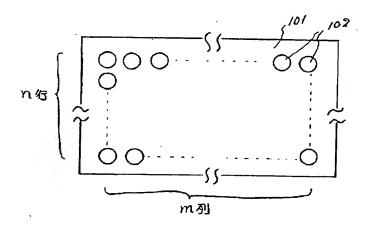
202 絶縁層

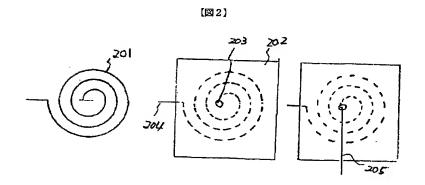
203 コンタクトホール

201、205 電源とのコンタクト部

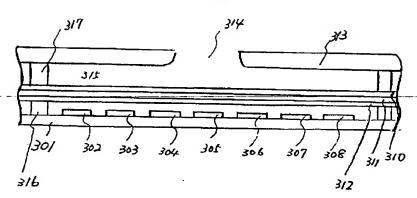
(4) 特開平4-368851 302、303、304、305 電磁石 402 発熱体 306、307、308 電磁石 403 ノズルプレート 310 基板 (フィルム) 404 インク 3 1 1 磁石層 405 ノズル 312 絶縁層 501 基板 313 ノズルブレート 502 圧電素子 314 ノズル 503 ノズルプレート 3 1 5 インク層 501 インク 316、317 接着層 505 ノズル 401 基板 10

[図1]

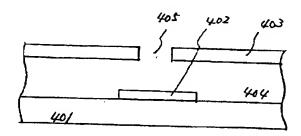




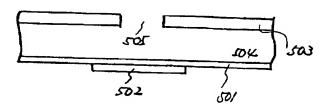




[図4]



【図5】



THIS PAGE BLANK (USPTO)